

МИНИСТЕРСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ОБЗОРЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ

Серия 2 «Полупроводниковые приборы»

ВЫПУСК 4 (1031)

В.В.Бачурин, В.С.Ежов, В. Ф. Синкевич
МОЩНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ МДП-ТРАНЗИСТОРЫ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Часть 3. Физические процессы, определяющие
предельные режимы работы мощных МДП-транзисторов
(по данным отечественной и зарубежной печати за 1970-1983 гг.)

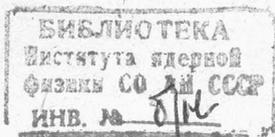
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
Глава 1. ЛАВИННЫЙ ПРОБОЙ	7
1. Основные факторы, определяющие напряжение лавинного пробоя	7
2. Распределение электрического поля в МДП-структурах	9
Глава 2. ЭФФЕКТ СМЫКАНИЯ	19
1. Механизм и внешнее проявление эффекта смыкания	19
2. Основные факторы, определяющие напряжение смыкания	20
Глава 3. ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ШНУРОВАНИЕ ТОКА	23
1. Основные экспериментальные законо- мерности	24
2. Механизмы и условия возникновения изотермической неустойчивости	27

МОСКВА

ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»

1984



	3. Методы контроля границ изотермической устойчивости	38
Глава 4.	ТЕПЛОВОЕ ШНУРОВАНИЕ ТОКА	39
	1. Основные экспериментальные закономерности, механизмы и условия возникновения тепловой неустойчивости	40
	2. Имитационное моделирование теплового шнурования	44
	3. Методы контроля границ тепловой устойчивости	51
Глава 5.	ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРУКТУРЫ НА ШНУРОВАНИЕ ТОКА	54
	1. Условия шнурования тока в структурах с неоднородностью	56
	2. Методы диагностики, основанные на контроле внешних характеристик	62
Глава 6.	ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЩНЫХ МДП-ТРАНЗИСТОРОВ	63
	1. Оптимизация конструкции	63
	2. Контроль и отбраковка дефектных структур	64
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	65